附件

**《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干举措**

**（征求意见稿）》公众意见采纳情况表**

| 序号 | 单位/个人 | 反馈意见建议 | 是否采纳 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位 | 建议在第（一）条实现核心芯片产品突破中，增加“交换芯片”。具体修改为“布局人工智能芯片、边缘计算芯片、交换芯片等专用芯片的开发” | 解释 | 《若干措施》中提到的“专用芯片”已包含“交换芯片”类别，不再另行强调。 |
| 2 | 个人 | 建议在第（一）条实现核心芯片产品突破措施中，增加对龙芯相关支持政策，将龙芯提升到国家标准，政府机构入股龙芯公司，成立龙芯产业联盟。 | 采纳 | 已增加对基于龙芯等自主指令集的芯片研发支持。 |
| 3 | 建议在第三部分加速突破基础支撑环节中，减少对EDA公司补贴，应由政府入股EDA公司，同时带领高校也入股。 | 解释 | 《若干措施》第（十三）条完善产业投融资环境已包含支持对EDA等集成电路企业的股权投资。 |
| 4 | 建议在第四部分聚力增强产业发展动能中，增加操作系统和软件生态的扶持政策。 | 解释 | 我市已出台针对操作系统等软件的《深圳市推动软件产业高质量发展的若干措施》。 |
| 5 | 建议针对第五部分构建高质量人才保障体系，应基于龙芯和鸿蒙国标，打造从小学到大学的认证开发教材，对于计算机方面，数学方面和化学等方面的学生，也要纳入人才管理，企业把研发任务布置给学校，学生可以通过学校途经领取研发任务，通过验收等方式，判断是否为人才，可以获得奖学金和升学等福利待遇等。 | 解释 | 该建议主要涉及基础教育层面的发展规划，不属于本《若干措施》重点关注部分，相关意见已转教育部门。 |
| 6 | 单位 | 建议在第一部分适用机构和重点支持领域中，增加“砷化镓（GaAs）,磷化铟（InP）等化合物半导体”。 | 解释 | 《若干措施》中提到的“化合物半导体”已包含“砷化镓（GaAs）,磷化铟（InP）”，不再另行强调。 |
| 7 | 单位 | 建议在第（六）条加快EDA核心技术攻关中，增加对企业采购或者租赁外国EDA给予相关补贴。 | 解释 | 根据《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划（2022-2025年）》，EDA工具软件培育工程重点加大国产EDA工具推广应用力度。 |
| 8 | 建议在第五部分构建高质量人才保障体系中，针对白名单重点发展企业，如果招聘超过35岁博士、产业界应用型低中高端人才，给予相应不同档次的政策扶持。 | 解释 | 该建议属于通用人才政策规划内容，不属于本《若干措施》重点关注部分。 |
| 9 | 单位 | 建议在第（一）条实现核心芯片产品突破中，对深圳企业销售自研芯片，奖励条件从单款销售金额累计超过2000万元调低到500-800万元。 | 部分采纳 | 结合市财政用于战略性新兴产业扶持的预算并参考了其他城市资助标准，补助条件已调低到“1000万元” |
| 10 | 建议在第（六）条加快EDA核心技术攻关中，增加对企业采购或者租赁外国EDA给予相关补贴。 | 解释 | 根据《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划（2022-2025年）》，EDA工具软件培育工程重点加大国产EDA工具推广应用力度。 |
| 11 | 建议在第四部分聚力增强产业发展动能中，增加促进本地集成电路技术与产品本地应用的内容：  1）建立本地半导体与集成电路优质技术与产品推荐目录，在市级各部门及国有企事业单位采购中，政府投资项目、重大项目建设中，同等条件下优先选用本地集成电路企业的技术与产品；  2）对使用本地半导体与集成电路技术与产品的本地企业，在享受相关政策、申报相关资助时，给予一定的优先支持；  3）政府相关主管部门应积极组织、协调本地集成电路上下游产业链协作，搭建本地集成电路技术、产品与本地应用的桥梁，进一步促进深圳集成电路产业健康发展。 | 解释 | 1.根据《公平竞争审查制度实施细则》的相关规定，不得对外地和进口商品、服务实行歧视性价格和歧视性补贴政策，不得排斥或者限制外地经营者参加本地招标投标活动。  2.《若干措施》中已包含组织、协调本地集成电路上下游产业链协作内容。 |
| 12 | 建议在第七部分附则中，删除“本措施与市区两级其他同类优惠措施，由企业按照就高不就低的原则自主选择申报，不重复资助”。 | 部分采纳 | 已删除区级优惠措施的内容。 |
| 13 | 单位 | 建议在第（一）条实现核心芯片产品突破中，增加“DPU”。具体修改为“重点突破CPU、GPU、DPU、DSP、FPGA等高端通用芯片的设计” | 采纳 | 已采纳修改。 |
| 14 | 单位 | 建议在第一部分适用机构和重点支持领域中，增加“高端贴片设备”。具体修改为“光刻、高端贴片设备、刻蚀、离子注入、沉积、检测设备等先进装备及关键零部件生产” | 解释 | 《若干措施》中提到的“先进装备”已包含高端贴片设备，不再另行强调。 |
| 15 | 建议在第（八）条突破核心设备及零部件配套中，增加“高端贴片设备”。具体修改为“...推进高端贴片设备、检测设备、薄膜沉积设备、刻蚀设备、清洗设备、高真空泵等高端设备部件和系统集成开展持续研发和技术攻关。” | 解释 | 《若干措施》中提到的“先进装备”已包含高端贴片设备，不再另行强调。 |
| 16 | 建议在第（三）条提升半导体制造能力中，增加鼓励既有“第三半导体衬底生产线”改造升级。具体修改为“...鼓励既有第三半导体衬底生产线和集成电路生产线改造升级。” | 解释 | 根据《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划（2022-2025年）》，先进制造补链工程重点鼓励集成电路生产线改造升级。 |
| 17 | 单位 | 建议在第一部分适用机构和重点支持领域中，增加重点支持“高端功率器件芯片（包括超结MOSFET、IGBT器件及模块，微小RDS（on）的中低压SGT MOS等”芯片设计。 | 部分采纳 | 重点支持领域已增加高端功率器件芯片设计。 |
| 18 | 单位 | 建议第（七）条推动关键材料自主可控措施中，增加支持“先进电子封装材料”的研发与生产。具体修改为“依托骨干企业加快光掩模、光刻胶、聚酰亚胺、溅射靶材、高纯度化学试剂、电子气体、蚀刻液、清洗剂、抛光液、电镀液功能添加剂、氟化冷却液、陶瓷粉体、先进电子封装材料等半导体材料的研发生产”。 | 采纳 | 已采纳修改。 |
| 19 | 建议在第（十二）条强化产业支撑平台建设中，将“工艺验证平台”纳入公共服务平台范围。具体修改为“建设集成电路领域制造业创新中心、产业创新中心、IC设计平台、设备材料研发中心、检测认证中心、工艺验证平台等公共服务平台”。 | 采纳 | 已采纳修改。 |
| 20 | 建议在第（十六）条加强人才激励保障中，增加对“承担国家级创新载体平台建设任务或承担国家重大科技专项的科研机构”政策支持。具体修改为“对在列入国家鼓励的重点集成电路企业清单单位、承担国家级创新载体平台建设任务或承担国家重大科技专项的科研机构从事基础研究、核心技术研发的人才，给予一定年限的稳定支持。” | 采纳 | 已采纳修改。 |
| 21 | 建议在第（十八）条产学联动培养各层次专业人才中，增加鼓励“科研机构”与企业共建高技能人才培训基地。具体修改为“鼓励有条件的高校（含技师学院）、科研机构采取与集成电路企业合作的方式共建高技能人才培训基地” | 采纳 | 已采纳修改。 |
| 22 | 单位 | 建议在第（五）条加速化合物半导体成熟中，将补助条件降低为年度采购深圳设计或制造的化合物半导体产品金额达1000万元（含）以上的企业。 | 采纳 | 已采纳修改。 |
| 23 | 单位 | 建议将“集成光路”提高到和“集成电路”同等重要的水平和高度。 | 解释 | 《若干措施》已包括支持突破光电子芯片。 |
| 24 | 建议把制造提高到比设计更重要的位置，在措施中把制造提到设计的前面。 | 解释 | 《若干措施》按照产业链的上下游排列，前后顺序与重要性无直接关系。 |
| 25 | 建议将文中“氮化镓、碳化硅等化合物半导体制造”，改为“砷化镓、磷化铟、铟镓砷磷（四元化合物半导体）、氮化镓、碳化硅等化合物半导体制造”。 | 解释 | 《若干措施》中提到的“化合物半导体”已包含“砷化镓、磷化铟、铟镓砷磷”类别，不再另行强调。 |
| 26 | 单位 | 建议在第一部分适用机构和重点支持领域中，明确适用对象是否包括总部设立在深圳，同时将部分生产、研究职能放置在深圳市外附属机构的企业。 | 解释 | 根据《公平竞争审查制度实施细则》的相关规定，不得违反商品要素自由流通标准的要求，已删除相关表述。 |
| 27 | 建议在第一部分适用机构和重点支持领域中，将“提供相关集成电路产业服务”的表述调整为“提供或开展相关集成电路产业服务或研究”。 | 采纳 | 已采纳修改。 |
| 28 | 建议在第（一）条实现核心芯片产品突破中，明确“研发投入1000万元（含1000万元）以上”是否有期限要求。 | 解释 | 该建议属于实施细则，将在申报指南中予以明确。 |
| 29 | 建议对第（一）条实现核心芯片产品突破及文件中多处提及“深圳企业”进行界定，以便明晰范围。 | 解释 | 根据《公平竞争审查制度实施细则》中不得违反商品要素自由流通标准的要求，已删除相关表述。 |
| 30 | 建议在第（一）条实现核心芯片产品突破中，明确“单款销售金额累计超过2000万元”中“单款”的界定，以及“最高1000万元”是否为每年的限额 | 解释 | 该建议属于实施细则，将在申报指南中予以明确。 |
| 31 | 建议在第（七）条推动关键材料自主可控中，明确“按照不超过研发费用（含材料验证测试费用）的40%给予补助，最高1000万元”是否有期限的要求。 | 解释 | 该建议属于实施细则，将在申报指南中予以明确。 |
| 32 | 建议在第（七）条推动关键材料自主可控中，明确“按一定期限内产品实际销售总额…”中“一定期限”的具体期限。 | 解释 | 该建议属于实施细则，将在申报指南中予以明确。 |
| 33 | 建议在（八）条突破核心设备及零部件配套中，明确“按一定期限内产品实际销售总额…”中“一定期限”的具体期限。 | 解释 | 该建议属于实施细则，将在申报指南中予以明确。 |
| 34 | 建议在第（八）条突破核心设备及零部件配套中，将落户奖励的金额与实际投资额等因素挂钩。 | 解释 | 该建议属于实施细则，将在申报指南中予以明确。 |
| 35 | 建议在第（十一）条支持企业做大做强中，明确此处对应不同档次营业收入的一次性奖励是否可以重复适用，以及深圳集成电路EDA、IP及设计企业营业收入首次突破20亿元的奖励标准。 | 采纳 | 已增加“每上一个台阶奖励一次”的表述，增加设计企业营收达到20亿元时的奖励标准。 |
| 36 | 个人 | 建议悬赏对光刻机有新型制作方法或思路的个人或集体给予重酬。 | 解释 | 《若干措施》已支持推进高端设备部件和系统集成开展持续研发和技术攻关，包含“光刻机”设备，不再另行强调。 |
| 37 | 单位 | 建议在第（一）条实现核心芯片产品突破和第（二）条加强对设计企业流片支持的措施中，重点扶持高性能计算、人工智能、高性能服务器。 | 解释 | 《若干措施》中提到的“高端通用芯片、专用芯片、核心芯片”已包含高性能计算、人工智能、高性能服务器类别，不再另行强调。 |
| 38 | 建议在第（十八）条产学联动培养各层次专业人才中，增加匹配产业发展规划，重点加强制造类的人力培养，优化高等院校在材料、设备、部件、EDA等领域的学科与专业设置，扩大招生数量。 | 解释 | 该建议主要涉及人才规划政策及高等教育专业设置相关规划政策，不属于本《若干措施》重点关注部分。 |
| 39 | 建议增加针对半导体从业人员的税收减免优惠、关键人才快速入籍和境外资产处理的绿色通道的具体措施。 | 部分采纳 | 1.根据《关于粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》,我市对在深圳工作并符合条件的港澳台及外籍高端紧缺人才，按内地与香港个人所得税税负差额给予补贴。  2.《若干措施》第（十七）条中已提到的拉通海外集成电路高层次人才“选引用留”全流程服务机制，提供全程代办服务。 |
| 40 | 建议在第（一）条实现核心芯片产品突破中，不要把对RISC-V芯片设计企业的支持单独列出。 | 采纳 | 已增加对开源指令集和自主指令集的支持。 |
| 41 | 建议把“三、加速突破基础支撑环节”中的第六条“加快EDA核心技术攻关”前移调整到“二、全面提升产业链核心环节”，全面提升产业链核心环节”部分。 | 解释 | EDA工具软件直接支撑半导体与集成电路设计和制造环节。 |
| 42 | 建议不要把应对美国出口管制的具体措施细节写入公开的政府文件 | 采纳 | 已采纳修改。 |
| 43 | 单位 | 建议在第（八）条突破核心设备及零部件配套中，增加“高端精细电镀、显影、去膜等设备”。 | 解释 | 《若干措施》中提到的“核心设备”已包含高端精细电镀、显影、去膜等设备，不再另行强调。 |
| 44 | 建议在第（八）条突破核心设备及零部件配套中，对进本地企业自行开展的能够稳定半导体集成电路产业链内循环，支撑半导体集成电路产业链的企业，给予一次性奖励，而不仅限于外部引进的龙头企业。 | 解释 | 资助阶段不同，《若干措施》已有对支撑半导体集成电路产业链的本地企业给予资助的措施。 |
| 45 | 建议针对第（十三）条完善产业投融资环境中“探索设立市级集成电路产业投资基金”，前期对集成电路产业通过现有市场开展的融资，按融资金额给予直接奖励，后期专项投资基金设立后，也可作为参考基础。 | 解释 | 《若干措施》第（十三条）已明确金融支持政策，不再另行强调。 |
| 46 | 建议在第（十七）条实施集成电路全球人才回溯计划中，结合实际工作经验，增加对海外高端人才的工作经历考察评估，对选引用留的集成电路人才认定方面，除了学历、头衔等认定条件外，增加对在国际顶尖集成电路或半导体企业合作或者工作过的技术人才认定。 | 解释 | 该建议属于实施细则，将在申报指南中予以明确。 |
| 47 | 个人 | 建议在第（一）条实现核心芯片产品突破中，增加对智能汽车芯片的支持：抓住汽车电动化和智能化带来的百年未有之变革机会，全面布局第三代“中央+区域控制”电子电气架构芯片，重点开发中央处理器、区域控制器、终端部件智能处理器等芯片。 | 解释 | 我委另行起草了《深圳市关于促进智能网联汽车产业高质量发展的若干措施（征求意见稿）》，该政策已包含了汽车芯片相关支持内容。 |
| 48 | 建议在第（四）条聚力增强产业发展动能中，增加通过市场化方式推动集成电路产品全面应用。以更大力度支持集成电路产品进入下游整机应用产品，鼓励本市产业上下游相关企业形成紧密研发和市场合作关系，不断激发集成电路企业和下游应用企业活力。支持集成电路进入下游整机企业供应链，按一定期限内产品实际销售总额给予研制单位不超过30%，最高2000万元奖励。 | 解释 | 《若干措施》对企业实现销售收入已有相应的奖励措施。 |
| 49 | 单位 | 建议全文表述中的适用范围增加功率器件、设计服务、高校等。 | 采纳 | 已采纳修改。 |
| 50 | 建议第一部分适用机构和重点支持领域，修改为“本措施适用于注册地、统计地及纳税地均在深圳市的半导体与集成电路设计、设计服务、制造、封装测试、设备、材料企业，或提供相关产业服务的企业、机构或组织。本措施具体条款另有规定的除外。” | 部分采纳 | 提供相关产业服务已包括设计服务。 |
| 51 | 建议在第一部分适用机构和重点支持领域中，将“重点支持高端通用芯片、专用芯片和核心芯片、化合物半导体芯片等芯片设计；硅基集成电路制造；氮化镓、碳化硅等化合物半导体制造；”修改为“重点支持高端通用芯片、专用芯片和核心芯片、化合物半导体芯片、高端功率器件等芯片设计；硅基集成电路制造；高端功率器件制造；氮化镓、碳化硅等化合物半导体制造；” | 部分采纳 | 硅基集成电路制造及化合物半导体制造已包含高端功率器件制造，不再另行强调。 |
| 52 | 建议在第（一）条实现核心芯片产品突破中，增加“MCU”。具体修改为“重点突破CPU、GPU、DSP、FPGA、MCU等高端通用芯片的设计”。 | 解释 | 《若干措施》中提到的“高端通用芯片”已包括MCU，不再另行强调。 |
| 53 | 建议在第（一）条实现核心芯片产品突破中，对深圳企业销售自研芯片，奖励条件从单款销售金额累计超过2000万元调低到500万元。 | 部分采纳 | 结合市财政用于战略性新兴产业扶持的预算并参考了其他城市资助标准，补助条件已调低到“1000万元” |
| 54 | 建议在第（二）条加强对设计企业流片支持中，将“高校和科研院所、功率器件企业”纳入支持范围，在后续政策细则中考虑增加“可提供海外形式发票”。 | 部分采纳 | 已增加对高校和科研院所的流片支持，并将“集成电路设计企业”修改为“半导体与集成电路设计企业”。 |
| 55 | 建议在第（三）条提升半导体制造能力中，将“加强与集成电路制造企业合作，规划建设逻辑工艺和特色工艺集成电路生产线...鼓励既有集成电路生产线改造升级。”修改为“加强与集成电路、功率器件制造企业合作，规划建设逻辑工艺和特色工艺集成电路生产线...鼓励既有集成电路和功率器件生产线改造升级。” | 部分采纳 | 1.已将“集成电路制造企业”修改为“半导体与集成电路制造企业”。  2.根据《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划（2022-2025年）》，先进制造补链工程重点鼓励集成电路生产线改造升级。 |
| 56 | 建议在第（四）条赶超高端封装测试水平中，将“按照项目实际投资额的10%给予补助，单个项目不超过1000万元。”修改为“按照项目实际投资额的20%给予补助，单个项目不超过1000万元。” | 部分采纳 | 已将补助比例提升为15%。 |
| 57 | 建议第（六）条加快EDA核心技术攻关，修改为“推动模拟、数字、射频、功率器件等集成电路等EDA工具软件实现全流程国产化。支持开展先进工艺及特色工艺制程、新一代智能、超低功耗等EDA技术的研发。加大国产EDA工具推广应用力度，鼓励企业、高校和科研机构购买或租用国产EDA工具软件，推动国产EDA工具进入高校课程教学。对购买/租用国产EDA工具软件的企业、高校和科研机构，分别按照不超过实际支出费用的70%/50%给予补助，每年最高分别为1000万元/500万元。对购买/租用国外EDA工具软件的企业、高校和科研机构，分别按照不超过实际支出费用的50%/30%给予补助，每年最高分别为500万元/300万元。” | 部分采纳 | 1.已增加高校为扶持对象。  2.模拟电路EDA工具已包括功率器件EDA，，不再另行强调。  3.根据《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划（2022-2025年）》，重点支持开展先进工艺、新一代智能、超低功耗等EDA技术的研发，支持国产EDA工具应用推广。 |
| 58 | 建议在第（九）条加大关键核心技术攻关支持力度中，将“集成电路”修改为“半导体与集成电路”。 | 已采纳 | 已采纳修改。 |
| 59 | 建议第（十）条积极承担国家专项战略任务，修改为“鼓励有关单位承担国家发展改革委、工业和信息化部、科学技术部、教育部、国家自然科学基金委等部委开展的半导体与集成电路领域重大项目、重大技术攻关计划和重点研发计划。根据国拨资金拨付进度，给予不超过1:1的资金配套，总额不超过项目总投资的30%。对重点核心企业提出的能够解决半导体与集成电路产业链“卡脖子”问题，但未获得国家资金的重大项目，根据企业自筹资金投入情况，可分阶段给予不超过30%的配套资金支持。对于成功申报国家产业创新中心、国家制造业创新中心、国家技术创新中心/省部级相关创新平台的，予以1:1/1:0.5配套支持。” | 部分采纳 | 《若干措施》原则配套支持国家级创新平台。 |
| 60 | 建议第（十一）条支持企业做大做强，修改为“对年度营业收入首次突破1亿元、3亿元、5亿元、10亿元的深圳半导体与集成电路EDA、IP及设计企业，分别给予企业核心团队500万元、700万元、1000万元和1200万元的一次性奖励。对年度营业收入首次突破5亿元、10亿元、20亿元、50亿元、100亿元的深圳半导体与集成电路制造、封装测试、关键装备和材料企业，分别给予企业核心团队300万元、500万元、700万元、1000万元和1200万元的一次性奖励。” | 已采纳 | 已采纳修改。 |
| 61 | 建议第（十二）条强化产业支撑平台建设，修改为“建设半导体与集成电路领域制造业创新中心、产业创新中心、IC设计平台、设备材料研发中心、检测认证中心等公共服务平台，以骨干企业、高校和科研机构为依托，联合上下游企业、高校和科研院所等构建中小企业孵化平台...” | 已采纳 | 已采纳修改。 |
| 62 | 建议在第（十五）条支持行业组织发挥桥梁作用中，增加按照实际“服务投入”的50%予以补贴。 | 已采纳 | 已采纳修改。 |
| 63 | 建议在第（十八）条产学联动培养各层次专业人才中，增加“积极推进高校申报建设国家集成电路产教融合创新平台，对于申报成功的院校，根据国拨资金拨付进度，给予1:1的资金配套。” | 解释 | 《若干措施》中提到的“人才培训基地”已包含“国家集成电路产教融合创新平台”，不再另行强调。 |
| 64 | 建议在第五部分构建高质量人才保障体系中，增加“加大人才培养支持力度。建立、健全集成电路专业人才培养培训体系。支持市内高等学校的集成电路和微电子学科专业设置，加快推动国家示范性微电子学院建设。对获得国家示范性微电子学院批复的高校给予3000万元资助；对获得集成电路科学与工程一级学科硕士学位培养点的高校给予最高不超过2000万元资助；对获得集成电路科学与工程一级学科博士培养点的高校给予最高不超过3000万元资助。” | 部分采纳 | 1.我市已有高校获批国家示范性微电子学院建设、集成电路科学与工程一级学科硕士学位培养点。  2.已增加“鼓励申报集成电路科学与工程、电子科学与技术一级学科博士点。” |
| 65 | 建议增加关于我市半导体与集成电路领域集成电路设计、制造、封装测试、设备、材料企业新增5亿以上的逻辑工艺、特色工艺集成电路生产线或超大规模晶圆级先进生产线等重大固定资产投资予以针对性的政策补贴，鼓励我市有技术基础的企业提升产业布局能力，抢占产业制高点，提升产业整体先进工艺技术水平发展。 | 解释 | 我市已有相关政策针对重大固定资产投资、技术改造的专项补贴政策。 |
| 66 | 单位 | 建议将第（六）条“加快EDA核心技术攻关”修改为“加快EDA核心技术攻关及业务发展”。 | 采纳 | 已采纳修改。 |
| 67 | 建议在第（六）条加快EDA核心技术攻关中，增加“鼓励骨干EDA企业（并购方）按照市场原则通过收购股权等方式，以实现合并或控制EDA行业境内外非关联企业的重大交易（并购重组）行为。对符合条件的并购方，单个项目按照并购交易金额的20%，给予并购方不超过5000万元的奖励。” | 部分采纳 | 已增加鼓励并购重组深圳市外EDA企业，且重组后的企业注册地和主要经营活动地在深圳的，按照并购交易额最高给予1000万元并购奖励。 |
| 68 | 建议在第（六）条加快EDA核心技术攻关中，增加“鼓励EDA企业做大做强，对连续三年年度营业收入超过1亿元的EDA企业，给予企业核心团队1000万元万元的一次性奖励。” | 不采纳 | 第（十一）条支持企业做大做强已包括对EDA企业的奖励政策。 |